

**Diode-Gleichrichter / diode-rectifier****Vorläufige Daten / preliminary data****Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Dio. forward current RMS maximum per diode	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{FRMSM}$	150	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{RMSM}$	180	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{FSM}$	1600 1400	A A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	13000 9500	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$

**Charakteristische Werte / characteristic values**

			min.	typ.	max.
Durchlassspannung forward voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, I_F = 150\text{ A}$	$V_F$		1,20	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{TO}$		0,83	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$r_T$		2,30	$\text{m}\Omega$
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, V_R = 1600\text{ V}$	$I_R$		1,00	mA
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	$R_{thJC}$			0,35 K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$R_{thCH}$		0,165	K/W

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-06-29
approved by: Matthias Leifeld	revision: 2.0



**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**Thyristor-Gleichrichter / thyristor-rectifier**  
**Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	1600	V
Durchlaßstrom Grenzeffektivwert pro Chip forward current RMS maximum per chip	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{FRMSM}$	150	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{RMSmax}$	180	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}$	$I_{FSM}$	1550 1300	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	12000 8450	$\text{A}^2\text{s}$
kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 60 754-6 $f = 50\text{Hz}, i_{GM} = 0,6\text{A}, di_G/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	$(di/dt)_{cr}$	100	$\text{A}/\mu\text{s}$
kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of on-state voltage	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, v_D = 0,67 \text{ VDRM}$	$(dv/dt)_{cr}$	1000	$\text{V}/\mu\text{s}$

**Charakteristische Werte / characteristic values**

Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, I_F = 150 \text{ A}$	$V_F$	1,30	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}$	$V_{(TO)}$	- 0,85	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}$	$r_T$	- 3,20	$\text{m}\Omega$
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6 \text{ V}$	$I_{GT}$	100	$\text{mA}$
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6 \text{ V}$	$V_{GT}$	2,0	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, v_D = 6 \text{ V}$ $T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, v_D = 0,5 \text{ VDRM}$	$I_{GD}$	6,0 3,0	$\text{mA}$
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, v_D = 0,5 \text{ VDRM}$	$V_{GD}$	0,3	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \Omega$	$I_H$	220	$\text{mA}$
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6 \text{ V}, R_{GK} \geq 20 \Omega$ $i_{GM} = 0,6 \text{ A}, di_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 10 \mu\text{s}$	$I_L$	550	$\text{mA}$
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{GM} = 0,6 \text{ A}, di_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}$	$t_{gd}$	1,2	$\mu\text{s}$
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, i_{TM} = 50 \text{ A}$ $V_{RM} = 100 \text{ V}, V_{DM} = 0,67 \text{ VDRM}$ $dv_D/dt = 20 \text{ V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$	$t_q$	150	$\mu\text{s}$
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, V_R = 1600 \text{ V}$	$I_R$ $I_D$	- 5,00	$\text{mA}$
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Thyristor per thyristor	$R_{thJC}$	0,30	$\text{K/W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Thyristor / per thyristor $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$R_{thCH}$	0,14	$\text{K/W}$

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-06-29
approved by: Matthias Leifeld	revision: 2.0



**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**IGBT-Brems-Chopper / IGBT-brake-chopper**  
**Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{Cnom}$ $I_C$	100 140	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	$I_{CRM}$	200	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$P_{tot}$	515	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

**Charakteristische Werte / characteristic values**

			min.	typ.	max.		
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 100\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 100\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 100\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	1,75 2,05 2,10	2,20	V V V	
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 3,55\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$V_{GEth}$	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$		$Q_G$	0,80			$\mu\text{C}$
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{Gint}$	7,50			$\Omega$
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{ies}$	6,30			nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{res}$	0,27			nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{CES}$			1,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{GES}$			100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ on}}$	0,16 0,17 0,17			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_r$	0,03 0,04 0,04			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ off}}$	0,33 0,43 0,45			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_f$	0,08 0,145 0,17			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{on}$	5,50 8,50 9,50			mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{off}$	5,50 8,50 9,50			mJ mJ mJ
Kurzschlussverhalten SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 900\text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{SC}$	360			A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT		$R_{thJC}$			0,29	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$R_{thCH}$	0,135			K/W

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-06-29
approved by: Matthias Leifeld	revision: 2.0



**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**Diode-Brems-Chopper / Diode-brake-chopper**  
**Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	1200	V
Dauergleichstrom DC forward current		$I_F$	50	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	$I_{FRM}$	100	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	510	$\text{A}^2\text{s}$

**Charakteristische Werte / characteristic values**

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 50\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_F$	1,70	2,15	V
	$I_F = 50\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		1,65		V
	$I_F = 50\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		1,65		V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 50\text{ A}, -di_F/dt = 3000\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$	54,0		A
		$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		60,0		A
		$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		63,0		A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 50\text{ A}, -di_F/dt = 3000\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$Q_r$	5,50		$\mu\text{C}$
		$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		8,80		$\mu\text{C}$
		$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		10,0		$\mu\text{C}$
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 50\text{ A}, -di_F/dt = 3000\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$	1,70		mJ
		$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		3,00		mJ
		$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		3,70		mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode				0,81	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$			0,375		K/W

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-06-29
approved by: Matthias Leifeld	revision: 2.0

# Technische Information / technical information

IGBT-Module  
IGBT-modules

# TDB6HK180N16RR\_B11



## Vorläufige Daten preliminary data

### Modul / module

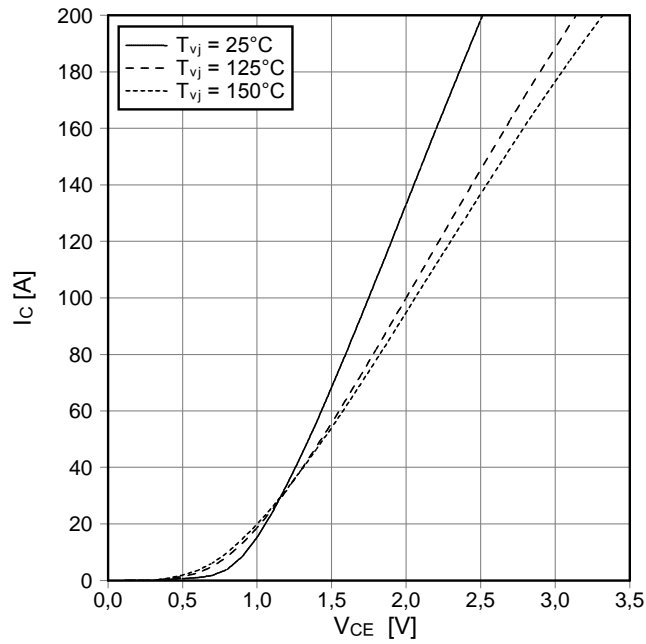
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V <sub>ISOL</sub>	2,5		kV
Material Modulgrundplatte material of module baseplate			Cu		
Material für innere Isolation material for internal insulation			Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		10,0		mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		7,5		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI	> 225		
			min.	typ.	max.
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	R <sub>thCH</sub>		0,02	K/W
Modulinduktivität stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		50	nH
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature	Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper Gleichrichter / rectifier	T <sub>vj max</sub>			175 °C 130 °C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions	Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper Gleichrichter / rectifier	T <sub>vj op</sub>	-40 -40		150 °C 130 °C
Lagertemperatur storage temperature		T <sub>stg</sub>	-40		125 °C
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M5 - mounting according to valid application note	M	3,00	-	6,00 Nm
Gewicht weight		G		180	g

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-06-29
approved by: Matthias Leifeld	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

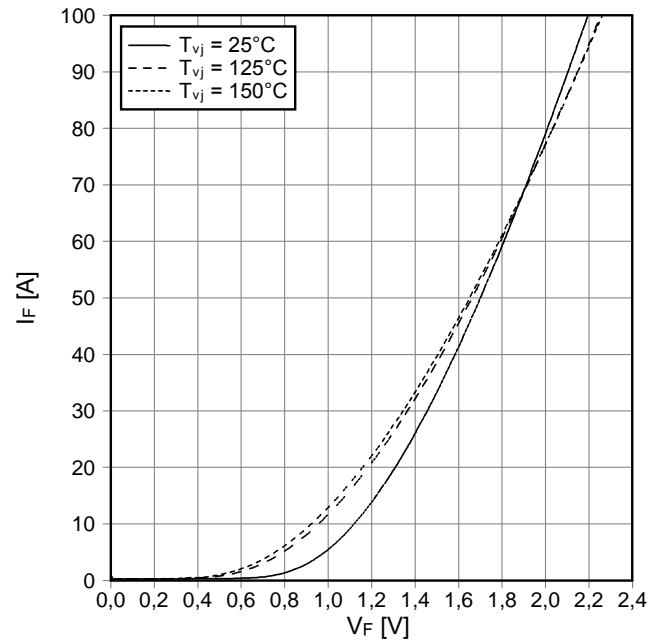
**Ausgangskennlinie IGBT-Brems-Chopper (typisch)**  
**output characteristic IGBT-brake-chopper (typical)**

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



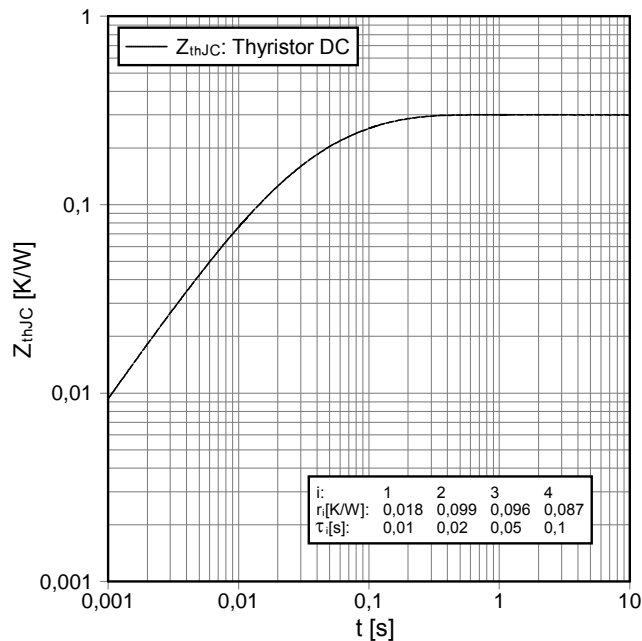
**Durchlasskennlinie der Diode-Brems-Chopper (typisch)**  
**forward characteristic of Diode-brake-chopper (typical)**

$I_F = f(V_F)$



**Transienter Wärmewiderstand Thyristor-Gleichrichter**  
**transient thermal impedance thyristor-rectifier**

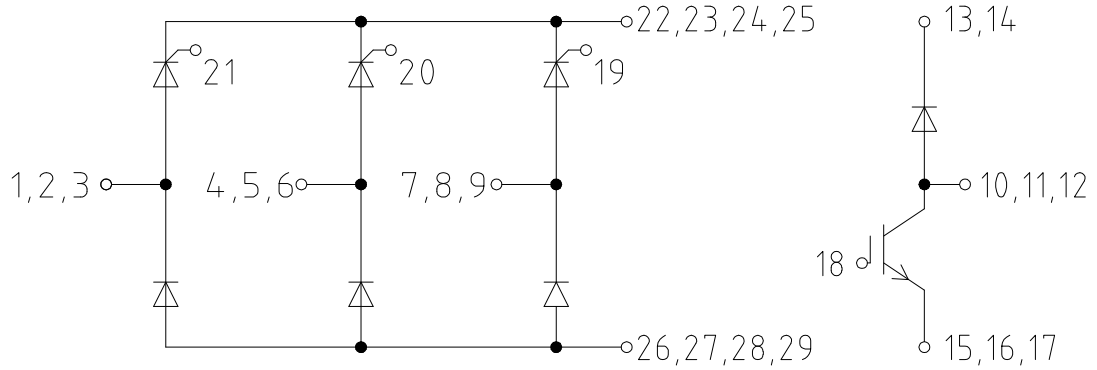
$Z_{thJC} = f(t)$



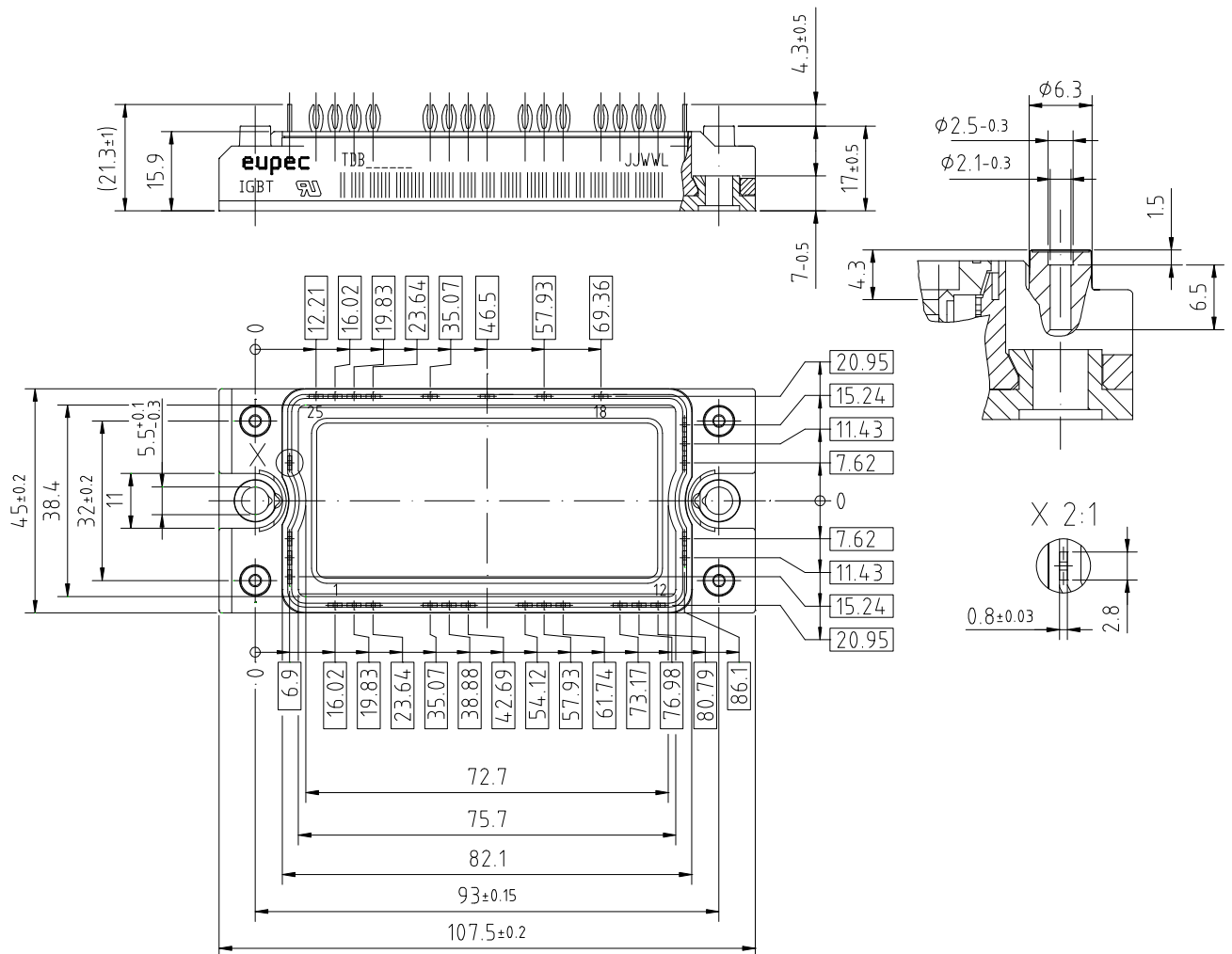
prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-06-29
approved by: Matthias Leifeld	revision: 2.0

Vorläufige Daten  
preliminary data

Schaltplan / circuit diagram



Gehäuseabmessungen / package outlines



prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-06-29
approved by: Matthias Leifeld	revision: 2.0



### **Nutzungsbedingungen**

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.eupec.com](http://www.eupec.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

### **Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.eupec.com](http://www.eupec.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2007-06-29
approved by: Matthias Leifeld	revision: 2.0



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Discrete Semiconductor Modules](#) category:*

*Click to view products by [Infineon](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[M254045V](#) [M254085](#) [DD380N16A](#) [DDB6U145N16L](#) [DR7306](#) [DZ540N26K](#) [EFG15D](#) [B484-2](#) [B485A-2](#) [B522F-2-YEC](#) [25.320.4853.1](#)  
[25.320.5253.1](#) [25.334.3253.1](#) [25.334.3353.1](#) [25.350.2053.0](#) [25.352.4753.1](#) [25.522.3253.0](#) [T2180N18TOF](#) [VT](#) [T484C](#) [T485F](#) [T485H](#) [T514F](#)  
[T554](#) [T582](#) [25.332.4353.1](#) [25.350.1653.0](#) [25.352.1453.0](#) [25.352.1653.0](#) [25.352.2453.0](#) [25.352.5453.1](#) [25.522.3353.0](#) [25.640.5053.0](#)  
[M252532V](#) [M252555](#) [M2550TB400](#) [M471B5673EH1-CH900](#) [M505012F-YEC](#) [TD330N16AOF](#) [B512-2T-YDA](#) [TT215N22KOF](#)  
[TT251N16KOF](#) [V100-35.200N](#) [V72-26.150M](#) [DD700N22K](#) [DD89N16K](#) [DD98N22K](#) [MSD30-12](#) [MSKD120-16](#) [TD500N16KOF](#)  
[TT425N18KOF](#)